# Заметки курса «Электричество и магнетизм»

Автор: Хоружий Кирилл

 ${f Or}$ : 29 октября 2020 г.

# Содержание

1	Закон Кулона и теорема Гаусса	1
2	Потенциал электрического поля.         2.1 Дифференциальная форма записи	3
3	Проводники           3.1 Основная задача электростатики	3
4	Диэлектрики         4.1 Теорема Гаусса	4 4 5
5	Энергия электрического поля	5
6	Виды диэлектриков	5
7	Теория постоянных токов	6
8	Магнитное поле в вакууме         8.1       Сила Ампера          8.2       Закон Био-Савара          8.3       Сила Лоренца	7 7 7
9	Магнитное поле в намагничивающихся средах         9.1       Уравнения максвелла для магнитного поля в веществе          9.2       Различные вещества          9.3       Граничные условия	8 8 8
10	Электромагнитная индукция	9
	10.1 Понимания          10.2 Сила Лоренца          10.3 Индуктивность проводов	9
	The state of the s	10 11

# 1 Закон Кулона и теорема Гаусса

Здесь попробуем индуктивно построить содержательную теорию, **начнём с двух эксперементальных** фактов, положенных в основу теории. Закона Кулона (сгсэ)

$$\boldsymbol{F} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\boldsymbol{r}}{r},\tag{1.1}$$

и, введя вектор напряженности электростатического поля  ${\pmb E} = {\pmb F}/q$ , принцип суперпозиции:

$$E = \sum E_i. \tag{1.2}$$

#### Дипольный момент

Простейшим примером системы зарядов является диполь  $q_1 + q_2 = 0$ , для которого введём  $\boldsymbol{p} = q \boldsymbol{l}$ :

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{r_1^2} \frac{\boldsymbol{r}_1}{r_1} - \frac{q}{r_1^2} \frac{\boldsymbol{r}_2}{r_2} \quad \overset{l \ll r_2, r_1}{\Longrightarrow} \quad \boldsymbol{E} = \frac{3(\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}}{r^3} - \frac{\boldsymbol{p}}{r^3}$$

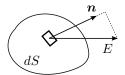
Для заряженной нити верно, что

$$E = 2\frac{\varkappa}{r}$$
.

Теперь дойдём до двух теорем (кусочки уравнений Максвелла), описывающих электростатическое поле.

**Thr 1.1** (теорема Гаусса). Для потока E через замкнутую поверхность S верно, что

$$\oint_{S} E_n \, dS = \left[ \oint_{S} (\boldsymbol{E} \, d\boldsymbol{S}) = 4\pi q_{\text{BH}}. \right] \tag{1.3}$$



 $\triangle$ .

- І. Доказательство (из закона Кулона) для сферы вокруг точечного заряда очевидно.
- II. Рассмотрим произвольную поверхность  $\Omega$ , содержащую заряд, и телесный угол в онной:

$$E_n dS = E \cos \alpha dS = E dS'$$

То есть поток через наклонную площадку равен потоку через тот же телесный угол через некоторую вспомогательную сферу. Так как  $s_1/s_2=r_1^2/r_2^2$  и  $E_1/E_2=r_2^2/r_1^2$ , получается интегрировать по  $\Omega$  то же самое, что и интегрировать по выбранной хорошей сфере.

- III. Рассмотрим теперь некоторую  $\Omega$ , не содержащую заряд. Посмотрим на телесный угол от q. По модулю потоки через них одинаковые, а знаки противоположны, следовательно вклада в поток через  $\Omega$  нет.
- IV. Для сложного распределения зарядов, по принципу суперпозиции верно, что

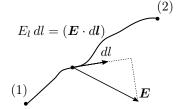
$$E = \sum_{i} E_{i} \quad \Rightarrow \quad \oint_{S} E_{n} dS = \sum_{i} \oint_{S} E_{i} dS.$$

# 2 Потенциал электрического поля.

**Thr 2.1** (Теорема о циркуляции). Для заряда, при квазистатическом перемещении, верно, что

$$A_{\text{замкн}} = \boxed{\oint_{(L)} (\boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l}) = 0}$$
 (2.1)

$$\cot \mathbf{E} = 0 \tag{2.2}$$



 $\triangle$ .

- I. Рассмотрим поле точечного заряда Q и перемещение с r до  $r+dl_r+(dl-dl_r)$ . Тогда  $dA=(\boldsymbol{E}\cdot dl)=\frac{Q}{r^2}dl_r$ , то есть  $A\equiv A(r_1,r_2)$ .
- II. Для поля в принципе вышесказанное верно по принципу суперпозиции.

**Def 2.2.** *Разностью потенциалов*  $\varphi_1 - \varphi_2$  между точками  $r_1$  и  $r_2$  называется  $A = \int_{r_1}^{r_2} E dl$ , при перемещении единичного положительного заряда. Потенциал определен с точностью до произвольной аддитивной постоянной.

В частности, для точечного заряда, при  $\varphi_{\infty} = 0$ , верно

$$\varphi(r) = \int_{r}^{\infty} \frac{Q(r)}{r^2} dr = \frac{Q}{r}.$$

2

A для двух зарядов, +q, -q

$$\varphi = -\frac{q}{r_1} + \frac{q}{r_2} = q \frac{(r_1 - r_2)}{r_1 r_2} \quad \stackrel{r \gg l}{\Rightarrow} \quad \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{(\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{r})}{r}$$

## 2.1 Дифференциальная форма записи

Вектор напряженности электростатического поля

$$E = -\operatorname{grad} \varphi. \tag{2.3}$$

Действительно,

$$d\varphi = -(\boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l}) = \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} dx_i = d\boldsymbol{l} \cdot \nabla \varphi, \text{ где } \nabla \varphi \equiv \operatorname{grad} \varphi.$$

А теперь рассмотрим некоторый элементарный параллелепипед. Тогда поток через левую грань это  $-E_x\,dy\,dz$ , а через правую это  $\left(E_x+\frac{\partial E_x}{\partial x}dx\right)\,dy\,dz$ . Тогда суммарный поток через мааленький параллелепипед равен  $dV\,\partial E/\partial x$ , а теорема Гаусса примет вид

$$\left(\frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial E}{\partial y} + \frac{\partial E}{\partial z}\right) dV = 4\pi\rho \, dV \quad \Rightarrow \quad \left[\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi\rho\right]. \tag{2.4}$$

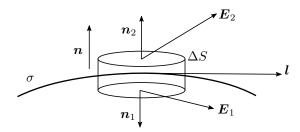
### 2.2 Граничные условия на заряженной поверхности

По теореме Гаусса верно, что

$$E_{2n_2} \Delta S + E_{1n_1} \Delta S = 4\pi \sigma \Delta S$$
,  
 $E_{2n} - E_{1n} = 4\pi \sigma$ 

По теореме циркуляции верно, что

$$E_{2l} \not\Delta l - E_{1l} \not\Delta l = 0$$
  
 $E_{2l} - E_{1l} = 0.$ 



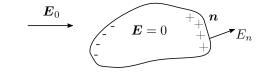
# 3 Проводники

**Def 3.1** (пусть так). *Проводник* – костяк частиц, окруженных *свободными* электронами, которые в пределах тела могут перемещаться на какие угодно расстояния.

В частности, для проводников, верно, что

$$E_n = 4\pi\sigma \tag{3.1}$$

$$E_{\tau} = 0 \tag{3.2}$$



Собственно, объёмных зарядов в проводнике нет, поверхностные есть и компенсируют внешнее поле. Аналогично работает решетка Фарадея, электростатическое поле не проникает в проводники.

#### 3.1 Основная задача электростатики

Вместо поиска E достаточно найти  $\varphi$ , воспользовавшись (2.3) и (2.4), получим

$$\operatorname{div}\operatorname{grad}\varphi\equiv\delta\varphi=\left\{ \begin{array}{ll} -4\pi\rho & \text{ур. Пуассона}\\ 0 & \text{ур. Лапласa} \end{array} \right.$$

Как может быть поставлена задача? Заданы граничные значение, найти распределения зарядов. Заданы заряды, найти распределения. Что-то задано, что-то не задано. Во всех трёх случаях решение уравнения Лапласа единственно.

#### Метод изображений

Если существует некоторая эквипотенциальная поверхность разделяющая пространство на два полупространства, то можем считать что эта поверхность является проводящей.

# 4 Диэлектрики

**Def 4.1.** Диэлектрики – непроводники электричества. В них возбуждаются индукционные заряды, привязанные к кастету частиц, – поляризационные, или связанные заряды.

Альтернативный вариант, – наличие дипольного момента у молекул. При наличии электрического поля дипольные моменты ориентируются, диэлектрик попользуется.

**Def 4.2.** Вектор поляризации – дипольный момент единицы объема диэлектрика, возникающий при его поляризации.

Рассмотрим скошенный параллелепипед. На основаниях параллелепипеда возникнут поляризационные заряды с поверхностной плотностью  $\sigma_{\text{пол}}$ . Взяв его площадь за S, найдём дипольный момент равный  $\sigma_{\text{пол}}Sl$ . Тогда вектор поляризации будет

$$P = \frac{\sigma_{\text{пол}} S}{V} l, \tag{4.1}$$

что верно и для анизотропных кристаллов где E 
mid P.

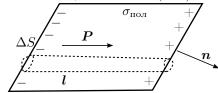
Пусть n – единичный вектор внешней нормали к основанию параллелепипеда, тогда  $V = S(l \cdot n)$ 

Подставив V в предыдущую формулу, получим, что

$$\sigma_{\text{пол}} = (\boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{n}) = P_n \tag{4.2}$$

Или, более общо,

$$m{P} = rac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} m{p}_i$$



В случае неоднородной поляризации верно, что поляризационные заряды могут появиться и на поверхности. Выделим V, ограниченный S, смещённый заряд равен  $-P_n \, dS$ , тогда через S поступает

$$q_{\text{пол}} = -\oint P_n dS = -\oint (\mathbf{P} \times d\mathbf{S}). \tag{4.3}$$

Стоит заметить, что в теорему о циркуляции не входят заряды, соотвественно для диэлектриков верно, что

$$\oint_{(L)} E_l \, dl = 0.$$

Далее чаще всего мы будем сталкиваться с линейной поляризацией, когда

$$P = \alpha E, \quad \Rightarrow \quad D = E \underbrace{(1 + 4\pi\alpha)}_{\varepsilon} = \varepsilon E,$$

где  $\alpha$  – поляризуемость диэлектрика, а  $\varepsilon$  – диэлектрическая проницаемость.

### 4.1 Теорема Гаусса

Запишем теорему Гаусса для электрического поля в диэлектрике. Знаем, что  $m{E} = m{E}_{ ext{non}} + m{E}_{ ext{cs}}$ 

$$\oint E_n dS = 4\pi (q + q_{\text{пол}}) \quad \Rightarrow \quad \oint \underbrace{(E_n + 4\pi P_n)}_{D_n} dS = 4\pi q. \quad \Rightarrow \quad \boxed{\oint D_n dS = 4\pi q_{\text{cB}}} \tag{4.4}$$

где  $D = E + 4\pi P$ . – вектор электрической индукции, или электрического смещения. Поток вектора D определяется только свободными зарядами.

Можно посмотреть на это в дифференциальной форме:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \boldsymbol{D} &= 4\pi \rho, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{E} &= 4\pi \left( \rho - \operatorname{div} \boldsymbol{P} \right), \\ \operatorname{div} \boldsymbol{E} &= 4\pi (\rho + \rho_{\text{пол}}) \quad \Rightarrow \quad \rho_{\text{пол}} = -\operatorname{div} \boldsymbol{P}. \end{aligned}$$

#### 4.2 Граничные условия на границе двух диэлектриков

Повторя рассуждения для проводников, найдём, что

$$D_{1n} = D_{2n}$$

а в случае линейных диэлектриков верно

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}.$$

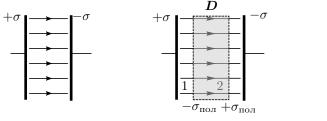
Или

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma_{\text{пол}}$$

Аналогично, из теоремы о циркуляции получим, что

$$E_{1\tau} - E_{2\tau} = 0.$$

#### Плоский конденсатор



$$D_2 = D_1 = E_0 = 4\pi\sigma$$
  $E_1 - E_2 = 4\pi\sigma \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right) = 4\pi\sigma_{\text{пол}}$ 

То есть на грани пластинки  $\sigma_{\text{пол}} = \sigma \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)$ .

### 4.3 Поле системы зарядов в однородном диэлектрике

Для точечного заряда в однородном диэлектрике, по теореме Гаусса

$$D \cdot 4\pi r^2 = 4\pi$$

$$D = \varepsilon E$$

$$\Rightarrow \qquad E = \frac{q}{\varepsilon r^2}.$$

То ест в общем случае, по принципу суперпозиции, в диэлектрике

$$m{E} = rac{1}{arepsilon} m{E}_0.$$

# 5 Энергия электрического поля

Рассмотрим систему из двух зарядов  $q_1$  и  $q_2$ . Тогда энергия взаимодействия

$$W = q_1 \varphi_{21} = q_2 \varphi_{12} = \frac{1}{2} (q_1 \varphi_{21} + q_2 \varphi_{12}).$$

Или, в общем случае

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i,i} W_{ij} = \frac{1}{2} \left( q_i \varphi_i^j \right) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} q_i \varphi_i,$$

где под  $\varphi_i$  имеется ввиду потенциал  $q_i$  заряда. В случае непрерывно заряженного тела

$$W = \frac{1}{2} \int \varphi \rho \, dV.$$

Например, для конденсатора

$$W = \frac{1}{2}\varphi_1 \int_{(1)} dq + \frac{1}{2}\varphi_2 \int_{(2)} dq = \frac{1}{2}q(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{1}{2}qU = \frac{cU^2}{2} = \frac{q^2}{2c}.$$

Вопрос: где локализована энергия? Ответ: в зарядах или в поле. В частности, для конденсатора

$$W = \frac{1}{2}cU^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon SE^2d^2}{4\pi d} = \underbrace{\frac{\varepsilon E^2}{8\pi}}_{\mathcal{W}_{\mathfrak{P}}}V,$$

где  $W_{\Im} = \varepsilon E^2/8\pi$  – объемная плотность электрической энергии. В общем же случае

$$W_{\mathfrak{S}} = \int \mathcal{W}_{\mathfrak{S}} \, dV. \tag{5.1}$$

# 6 Виды диэлектриков

Посмотрим на энергию внутри вакуума и диэлектрика,  $E^2/8\pi$  и  $E^2/\epsilon 8\pi$ . Энергия электрического поля определяется через работу внешних сил, которую необходимо затратить, чтобы это поле создать. Собственно,

во втором случае есть ещё добавки. рассмотрим диэлектрик с упругими диполями, то есть пусть

$$F = \varkappa l$$
.

Пусть диполь попал во внешнее поле, тогда

$$Eq \cdot \frac{l}{2} = \varkappa l \cdot \frac{l}{2} = \frac{1}{2} Ep.$$

Тогда вся энергия, чтобы создать в этой среде поле

$$W = \frac{E^2}{8\pi} + \frac{EP}{2} = \frac{E^2}{8\pi} + \frac{1}{2}E^2\alpha = \frac{E^2}{8\pi} + \frac{E^2}{8\pi}(\varepsilon - 1) = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi}.$$

А если работать с диэлектриками с собственным дипольным моментом? Тогда ещё появиться некоторое тепло, которое необходимо отдать термостату, увеличивая упорядоченность системы. Постараемся обобщить, для этого вспомним, что

**Def 6.1.** Свободная энергия – функция состояния, приращение которой в обратимом изотермическом процессе равно совершаемой работе внешних сил.

Так вот, то что мы называем энергией электрического поля (в диэлектриках), на самом деле это объёмная плотность свободной энергии  $\Psi = U - TS$ .

## 7 Теория постоянных токов

Def 7.1. Сила тока – заряд, протекший через сечений проводника в единицу времени,

$$I = \frac{dq}{dt}. (7.1)$$

Плотность тока – ток, протекающий через единичное сечение.

$$j = neu. (7.2)$$

**Law 7.2** (закон Ома). Для класса линейных проводников верно, что при наличии разности потенциалов U

$$I = \frac{U}{R} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{j} = \lambda \mathbf{E},\tag{7.3}$$

где  $\lambda = 1/\rho$ , обратное удельное сопротивление.

В СГСЭ, кстати, dim  $\rho = c$ , а в СИ 1 ед. СГСЭ  $\rho = 9 \cdot 10^9$  Ом.

#### Условие стационарности

Пусть в некоторый узел втекает  $I_1, \ldots, I_n$ , тогда

$$\oint_{(S)} j_n \, dS = -\dot{Q}.$$

Это «закон сохранения заряда», или уравнение непрерывности. В частности, в стационарном случае

$$\oint j_n \, dS = 0 \, .$$
(7.4)

Получается (??), что поле зарядов, которые участвуют в протекании постоянных токов можно описывает с помощью электростатических формул, то есть применять теорему Гаусса и теорему о циркуляции.

По теореме Гаусса и условия стационарности,

$$0 = \oint j_n \, dS = \lambda \oint E_n \, dS = \lambda 4\pi q,$$

то есть для проводников с постоянным током всё ещё верно, что внутреннего заряда в проводниках нет, а есть только поверхностный.

Невозможна стационарная ситуация с постоянных током только на потенциальных силах. Для участка цепи, в котором действуют сторонние силы, можно записать

$$j = \lambda \left( E + E^{\text{crop}} \right). \tag{7.5}$$

**Def 7.3.**  $\mathcal{I}$  — электро-движущая сила, работа совершаемая сторонними силами при перемещении единичного заряда по рассматриваемому участку,

$$\mathcal{E} = \int_{(I)} E_l^{\text{crop}} \, dl. \tag{7.6}$$

### Правила Кирхгофа

Рассмотрим узел, в который втекает  $I_1, \ldots, I_n$ . Из условия стационарности получим (I). Рассмотрев замкнутый участок цепи, получим (II) правило Кирхгофа. Действительно,  $j_l = \lambda \left( E_l + E_l^{\rm crop} \right)$ , или

I. 
$$\sum I_i = 0$$
.

$$\oint rac{I\,dl}{\lambda S} = \oint \left(E_l + E_l^{
m crop}
ight)\,dl,$$
 где  $\oint rac{I\,dl}{\lambda S} = IR.$ 

II. 
$$(\sum)I_iR_i = (\sum)\mathcal{E}_i$$

Но для каждого участка  $I_iR_i=\Delta\varphi_i+\mathcal{E}_i$  . Это с учётом направления тока.

*Оказывается*, для любой цепи, записав уравнения Кирхгофа для всех узлов и всех независимых контуров, получим разрешимую единственным образом систему уравнений (ну или хотя бы столько, сколько можно).

# 8 Магнитное поле в вакууме

## 8.1 Сила Ампера

Ампер ввел элементы тока, тогда

$$d\mathbf{F} = K_1 I \left[ d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \right], \tag{8.1}$$

где B – undykuus магнитного поля, силовая характеристика магнитного поля.

### 8.2 Закон Био-Савара

Ещё один эксперементальный факт:

$$d\mathbf{B} = K_2 I \frac{[d\mathbf{l} \times \mathbf{r}]}{r^3}. (8.2)$$

Осталось поговорить про коэффициенты  $K_1$  и  $K_2$ . Из  $I^{(\mathrm{M})}=\frac{1}{c}I^{(\Im)},$  получим в СГСМ:

$$d\mathbf{F} = I [\mathbf{l} \times \mathbf{B}]$$

$$d\mathbf{B} = I \frac{[d\mathbf{l} \times \mathbf{r}]}{r^3}.$$

$$d\mathbf{B} = \frac{I}{c} \frac{[d\mathbf{l} \times \mathbf{r}]}{r^3}.$$

$$d\mathbf{B} = \frac{I}{c} \frac{[d\mathbf{l} \times \mathbf{r}]}{r^3}.$$

Подставляя j = nqv, получим формулу следующего раздела.

## 8.3 Сила Лоренца

**Law 8.1.** Сила, действующая на движущийся точечный заряд q в магнитном поле, получен обобщением опытных фактов,

$$\boldsymbol{F}_{m} = \frac{q}{c} \left[ \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} \right], \tag{8.3}$$

где вектор  $\mathbf{B} \neq f(q,v)$  характеризует магнитное поле, напряженность магнитного поля.

Из этого можем найти, что

$$\boldsymbol{B} = \frac{c}{q\boldsymbol{v}_{\perp}^2} \left[ \boldsymbol{F}_m \times \boldsymbol{v}_{\perp} \right],$$

что однозначно определяет B.

В предположение, что электрическое и магнитное поля действуют независимо, то  ${\pmb F}={\pmb F}_e+{\pmb F}_m$ , т.е.

$$F = q \left( E + \frac{1}{c} \left[ v \times B \right] \right),$$

где  $\boldsymbol{F}$  – сила Лоренца.

 $<sup>^{1}</sup>$ В системе Гаусса  $I,q,\Delta\varphi$ измерется в СГСЭ, а B,H,L,M в СГСМ.

# 9 Магнитное поле в намагничивающихся средах

### 9.1 Уравнения максвелла для магнитного поля в веществе

Посмотрим на рамку с током в магнитном поле. Для неё верно, что суммарная сила, действующая на рамку,

$$\boldsymbol{B} \oint \, d\boldsymbol{F} = \frac{I}{c} \oint [\, d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}] = \frac{I}{c} \left[ \oint \, d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B} \right] = 0.$$

Однако момент, действующий на рамку, не равен 0,

$$S=ab, \quad F=rac{I}{c}bB \quad \Rightarrow \quad M=rac{IS}{c}\sin lpha \quad \Rightarrow \quad oldsymbol{p}_m=rac{IS}{c}oldsymbol{n} \quad \Rightarrow \quad oldsymbol{M}=[oldsymbol{p}_m imes oldsymbol{B}]\,.$$

Посмотрим теперь на рамку в неоднородном магнитном поле. Рассмотрим рамку такую, что  $p_m \parallel B$ , тогда  $I\,dl$  имеет проекцию на n, получается, что

$$F_x = (p_m)_x \frac{\partial B_x}{\partial x}.$$

Возвращая к полю, предполагается, что внутри молекул формируются *молекулярные токи*, создающие дополнительный магнитный момент, а при наличие внешнего поля происходит ориентация этих моментов. Тогда теорема о циркуляции магнитного поля в веществе запишется, как

$$\oint_{(L)} (\boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{l}) = \frac{4\pi}{c} \left( I_{\text{пров}} + I_{\text{мол}} \right).$$
(9.1)

Стоит заметить, что в теории Максвелла имеется ввиду, что

$$B = \langle B_{\mu} \rangle$$
.

Характеристика, описывающая состояние намагниченного вещества в точке – магнитный дипольный момент, единице объема:

$$\mathcal{I} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} \left( \boldsymbol{p}_m \right)_i.$$

Можем записать, что

$$\oint \mathcal{I}_l \, dl = \frac{I_{\text{мол}}}{c}.$$
(9.2)

Тогда уравнение перепишется, как

$$\oint_{(L)} (\boldsymbol{B} \, d\boldsymbol{l}) = \frac{4\pi}{c} I_{\text{пров}} + 4\pi \oint_{(L)} (\boldsymbol{\mathcal{I}} \, d\boldsymbol{l}). \tag{9.3}$$

$$\oint_{(L)} \underbrace{(B - 4\pi \mathcal{I})}_{\mathbf{H}} d\mathbf{l} = \frac{4\pi}{c} I_{\text{пров}},$$
(9.4)

здесь принимается определение  $H = B - 4\pi \mathcal{I}$  – напряженность магнитного поля.

Далее нас интересует линейная намагничиваемость:

$$\mathcal{I} = \varkappa H$$
.

где  $\varkappa$  – магнитная восприимчивость. Тогда можем записать, что

$$H\underbrace{(1+4\pi\varkappa)}_{\mu} = B,\tag{9.5}$$

что записано в системе Гаусса. В СИ верно, что

$$oldsymbol{H} = rac{oldsymbol{B}}{\mu_0} - oldsymbol{\mathcal{I}}.$$

#### 9.2 Различные вещества

- I. Парамагнетики,  $\varkappa \in [10^{-3}, 10^{-6}]$ , пример: алюминий.
- II. Диамагнетики,  $\varkappa < 0$ , пример: золото, серебро, см. модель Ланжевена.
- III. Ферромагнетики,  $\varkappa \in [10^3, 10^6]$ , пример: железо, никель.

### 9.3 Граничные условия

Рассмотрим границу двух веществ с  $\mu_1$  и  $\mu_2$ . Тогда

$$\boldsymbol{B}_{1n} = \boldsymbol{B}_{2n},$$

а для тангенциальной компоненты

$$H_{2\tau} - H_{1\tau} = \frac{4\pi}{c} i_N.$$

# 10 Электромагнитная индукция

#### 10.1 Понимания

**Def 10.1** (Понимание Фарадея). Для движущейся перемычки в замкнутом контуре, помещенного в магнитное поле, можно записать силу лоренца, которая будет толкать каждый носитель заряда в ней как:

$$E = \frac{F}{e} = \frac{1}{c}[v \times B].$$

Электродвижущая сила, создаваемая этим полем называется электродвижущей силой. И для магнитного потока пронизывающего площадь рамки:

$$\mathcal{E} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} \tag{10.1}$$

**Def 10.2** (Понимание Максвелла). Всякое изменение магнитного поля во времени возбуждает в окружающем пространстве электрическое поле. Циркуляция E по  $\forall$  замкнутому контуру определяется:

$$\oint_{s} (E \, ds) = -\frac{1}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial t}, \qquad \text{rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{10.2}$$

где  $\Phi = \oint_s {m B} \, d{m S}$  — магнитный поток, пронизывающий неподвижный контур s.

Сущность в таком понимании прежде всего в возбуждении электрического поля, а не тока. Электромагнитная индукция может наблюдаться и тогда, когда в пространстве нет проводников вообще.

## 10.2 Сила Лоренца

**Def 10.3.** *Сила Лоренца* для проводника движущегося в переменном магнитном поле ток возбуждается как магнитной, так и электрической силами:

$$\mathbf{F} = e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{v} \times \mathbf{B}]\right) \tag{10.3}$$

От выбора системы отсчета зависит, какая часть индукционного тока вызывается электрической, а какая магнитной составляющей силы Лоренца. Деление электромагнитного поля на электрическое и магнитное определяется системой отсчета, в которой рассматриваются явления.

С помощью пересадок, в общем случае, нельзя добиться того, чтобы электромагнитное поле сделалось либо чисто электрическим, либо чисто магнитным.

#### 10.3 Индуктивность проводов

**Def 10.4.** Предполагаем, что ферромагнетиков нет, тогда B и  $\Phi$  пропорциональны току:

$$\Phi = LI^{(m)} = \frac{1}{c}LI,\tag{10.4}$$

где  $I^{(m)}$  — сила тока в СГСМ, а I — сила того же тока в СИ, L же не зависит от силы тока и называется  $u + dy \kappa m u e ho c m b o n po so d a$ . Чем тоныше провод, тем болше его индуктивность.

### 10.4 Магнитная энергия

Для витка с током, в котором с помощью внешних сил потечёт ток, а значит будет нарастать и магнитный поток через него, возникнет ЭДС, тогда элементарная работа внешний сил:

$$\delta A^{\text{внеш}} = -\mathcal{E}^{\text{инд}} I \, dt = \frac{1}{c} I \, d\Phi.$$

**Def 10.5.** Из верхнего, достаточно общего утверждения, если работа внешняя работы пойдёт только на увеличение *магнитной энергии*, то есть диа- или парамагнетик, в частности.

$$dW_m = \frac{1}{c} d\Phi \qquad \stackrel{\text{$\not$}}{\leadsto} \Phi^{\text{ерромагнетиков}} \qquad W_m = \frac{L}{2} \left(\frac{I}{c}\right)^2 = \frac{1}{2c} I \Phi = \frac{\Phi^2}{2L}, \tag{10.5}$$

где L – самоиндукция проводника с током и константа. Также, для справедливости последней формулы не обязательно виток должен оставаться неподвижным.

Важно, что  $\mu$  остается постоянной, или же, если проницаемость зависит от температуры, то в процессе намагничивания, чтобы формула работала, надо поддерживать T постоянной.

Тогда  $W_m$  будет иметь смысл свободной магнитной энергии системы.

Можно перейти к другому виду записи энергии магнитного поля, энергия, которую запас соленоид, используя:

$$\begin{cases} H = 4\pi I/(cl) \\ \Phi = BS \end{cases} \rightsquigarrow dW_m = \frac{I}{c} d\Phi = \frac{V}{4\pi} (\boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{B})$$
 (10.6)

Если  $w_m$  – плотность магнитной энергии в соленоиде, то в общем случае можно записать  $W_m = \int w_m \, dV$ , где плотность определяется:  $w_m = (\boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{B})/(4\pi)$ .

В случае пара- и диамагнитный сред  ${\pmb B}=\mu {\pmb H}$  получаем:  $w_m=\mu H^2/(8\pi)$ 

Рассмотрим два витка с током по которым текут токи  $I_1$  и  $I_2$ . В отсутствии ферромагнетиков запишется:

$$\Phi_1 = \frac{1}{c}L_{11}I_1 + \frac{1}{c}L_{12}I_2,$$

$$\Phi_2 = \frac{1}{c}L_{21}I_1 + \frac{1}{c}L_{22}I_2.$$

Можно сформулировать **теорему о взаимности**  $L_{ik} = L_{ki}$ 

**Thr 10.6** (О сохранении магнитного потока). Проводник с током в  $\forall$  магнитном поле, движется и деформируется, тогда в нём возбуждается:

$$I = \frac{\mathcal{E}^{u n \partial}}{R} = -\frac{1}{cR} \frac{d\Phi}{dt}.$$

Eсли R=0, то  $d\Phi/dt=0$ , то есть при движении идеально проводящего замкнутого провода в магнитном поле остается постоянным магнитный поток, пронизывающий контур провода.

### 10.5 Уравнения Максвелла

Ди-форма в СГС: 
$$\dim \mathbf{A}$$
 Ин-форма в СГС:  $\dim \mathbf{D} = 4\pi \rho$   $\dim \mathbf{B} = 0$   $\dim \mathbf{B} = 0$